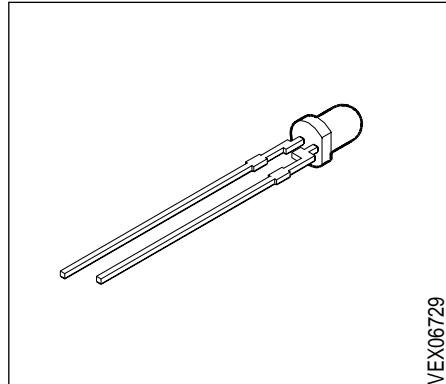


3 mm (T1) MULTILED®, Diffused

LSG 3351

Besondere Merkmale

- nicht eingefärbtes, diffuses Gehäuse
- antiparallel geschaltete Leuchtdiodenchips
- hohe Signalwirkung durch Farbwechsel der LED möglich
- bei geeigneter Ansteuerung mit IC (z.B. SDA 2231), Farbwechsel von grün über gelb und orange bis super-rot möglich
- beide Farben getrennt ansteuerbar
- gegurtet lieferbar
- Störimpulsfest nach DIN 40839



Features

- colorless, diffused package
- antiparallel chips
- high signal efficiency possible by color change of the LED
- with appropriate controlling by IC (e.g. SDA 2231) it is possible to change color from green to yellow, orange and super-red
- both colors can be controlled separately
- available taped on reel
- load dump resistant acc. to DIN 40839

Typ Type	Emissionsfarbe Color of Emission	Gehäusefarbe Color of Package	Lichtstärke Luminous Intensity $I_F = 10 \text{ mA}$ $I_V (\text{mcd})$	Bestellnummer Ordering Code
LSG 3351-HO	super-red / green	colorless diffused	≥ 2.5 (10 typ.)	Q62703-Q2297

Streuung der Lichtstärke in einer Verpackungseinheit $I_{V_{\max}} / I_{V_{\min}} \leq 2.0$.¹⁾

Streuung der Lichtstärke in einer LED $I_{V_{\max}} / I_{V_{\min}} \leq 3.0$.

¹⁾ Bei MULTILED® bestimmt die Helligkeit des jeweils dunkleren Chips in einem Gehäuse die Helligkeitsgruppe der LED.

Luminous intensity ratio in one packaging unit $I_{V_{\max}} / I_{V_{\min}} \leq 2.0$.¹⁾

Luminous intensity ratio in one LED $I_{V_{\max}} / I_{V_{\min}} \leq 3.0$.

¹⁾ In case of MULTILED®, the brightness of the darker chip in one package determines the brightness group of the LED.

Grenzwerte¹⁾**Maximum Ratings¹⁾**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values	Einheit Unit
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	– 55 ... + 100	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	– 55 ... + 100	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 100	°C
Durchlaßstrom Forward current	I_F	40	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu\text{s}, D = 0.005$	I_{FM}	0.5	A
Verlustleistung Power dissipation $T_A \leq 25 \text{ } ^\circ\text{C}$	P_{tot}	140	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht / Luft Junction / air	$R_{th JA}$	400	K/W

¹⁾ Die angegebenen Grenzdaten gelten für den Chip, für den sie angegeben sind, unabhängig vom Betriebzustand des anderen.

¹⁾ The stated maximum ratings refer to the specified chip regardless of the other one's operating status.

Kennwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Characteristics

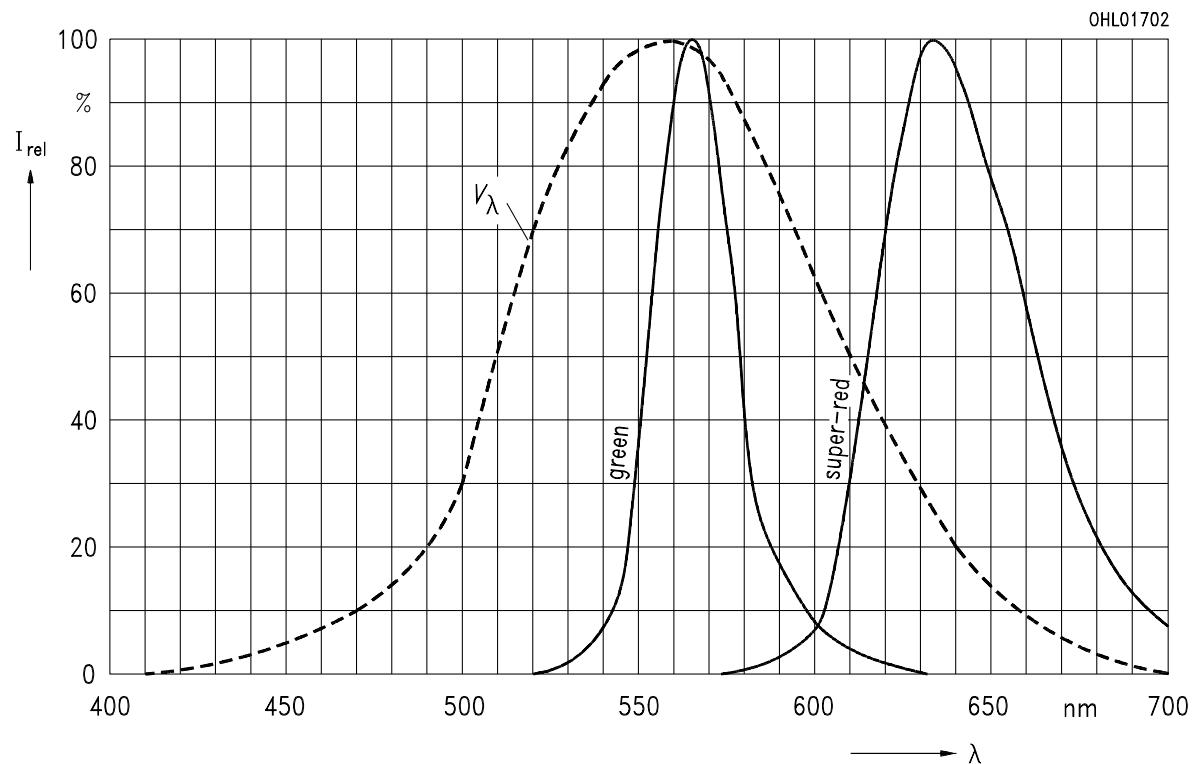
Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values		Einheit Unit
		super-red	green	
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission $I_F = 20 \text{ mA}$	(typ.) (typ.) $I_F = 20 \text{ mA}$	λ_{peak}	635 565	nm
Dominantwellenlänge Dominant wavelength $I_F = 20 \text{ mA}$	(typ.) (typ.) $I_F = 20 \text{ mA}$	λ_{dom}	628 570	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 20 \text{ mA}$	(typ.) (typ.) $I_F = 20 \text{ mA}$	$\Delta\lambda$	45 25	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % I_V		2ϕ	50 50	Grad deg.
Durchlaßspannung Forward voltage $I_F = 10 \text{ mA}$	(typ.) (max.) $I_F = 10 \text{ mA}$	V_F V_F	2.0 2.6	V V
Kapazität Capacitance $V_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	(typ.)	C_0	27	
Schaltzeiten: Switching times: I_V from 10 % to 90 % I_V from 90 % to 10 % $I_F = 100 \text{ mA}, t_P = 10 \mu\text{s}, R_L = 50 \Omega$	(typ.) (typ.) $I_F = 100 \text{ mA}, t_P = 10 \mu\text{s}, R_L = 50 \Omega$	t_r t_f	300 150 200	450 ns ns

Relative spektrale Emission $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $I_F = 20 \text{ mA}$

Relative spectral emission

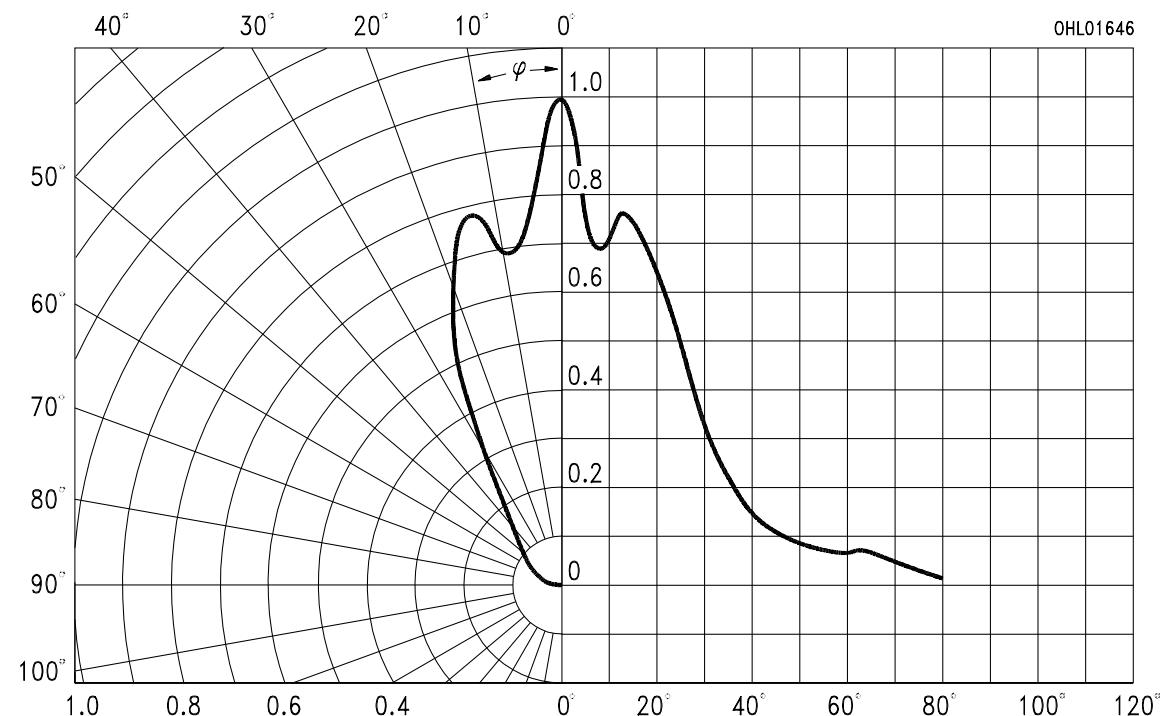
$V(\lambda) = \text{spektrale Augenempfindlichkeit}$

Standard eye response curve



Abstrahlcharakteristik $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$

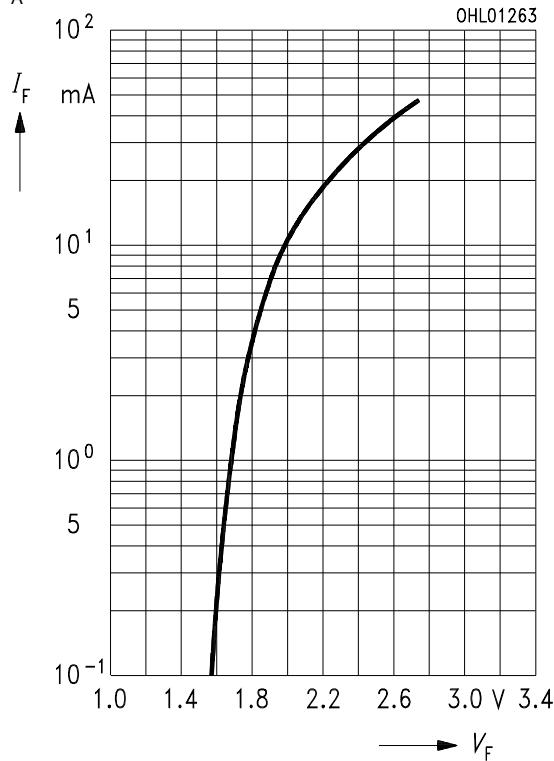
Radiation characteristic



Durchlaßstrom $I_F = f(V_F)$

Forward current

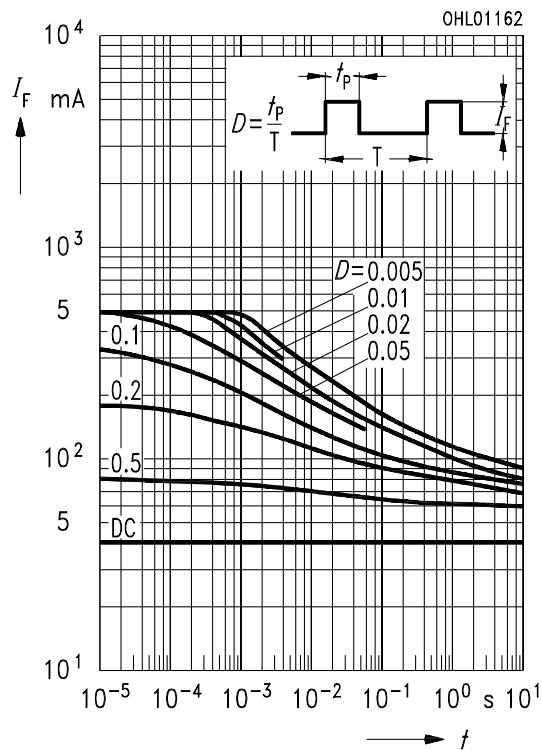
$T_A = 25^\circ\text{C}$



Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_P)$

Permissible pulse handling capability

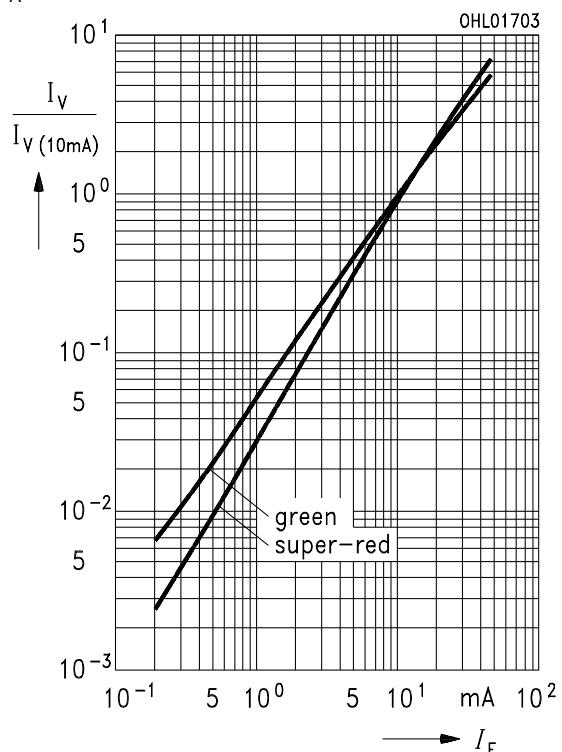
Duty cycle D = parameter, $T_A = 25^\circ\text{C}$



Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(10\text{ mA})} = f(I_F)$

Relative luminous intensity

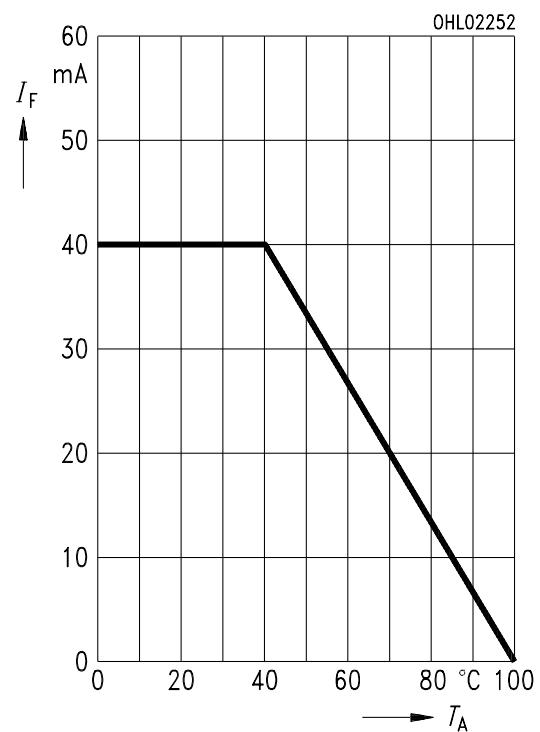
$T_A = 25^\circ\text{C}$



Maximal zulässiger Durchlaßstrom

Max. permissible forward current

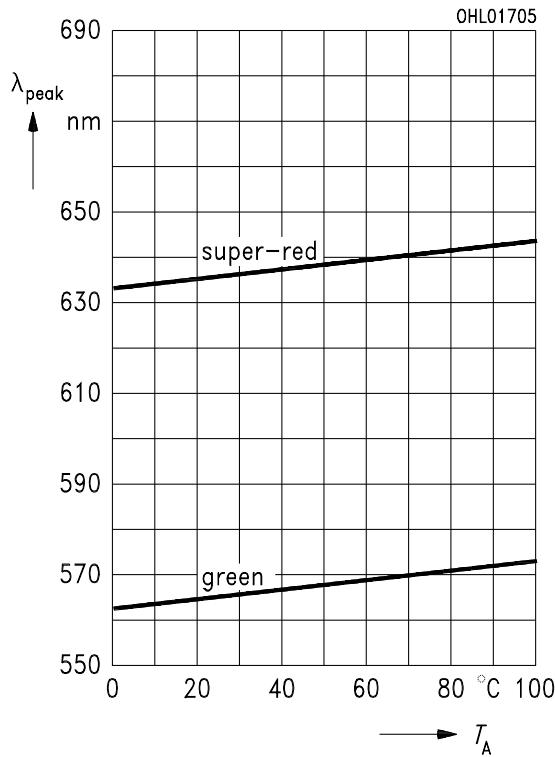
$I_F = f(T_A)$



Wellenlänge der Strahlung $\lambda_{\text{peak}} = f(T_A)$

Wavelength at peak emission

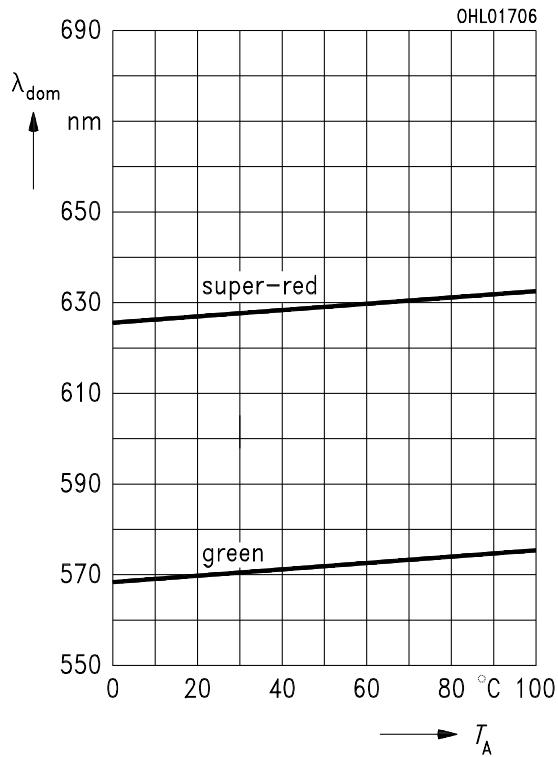
$I_F = 20 \text{ mA}$



Dominantwellenlänge $\lambda_{\text{dom}} = f(T_A)$

Dominant wavelength

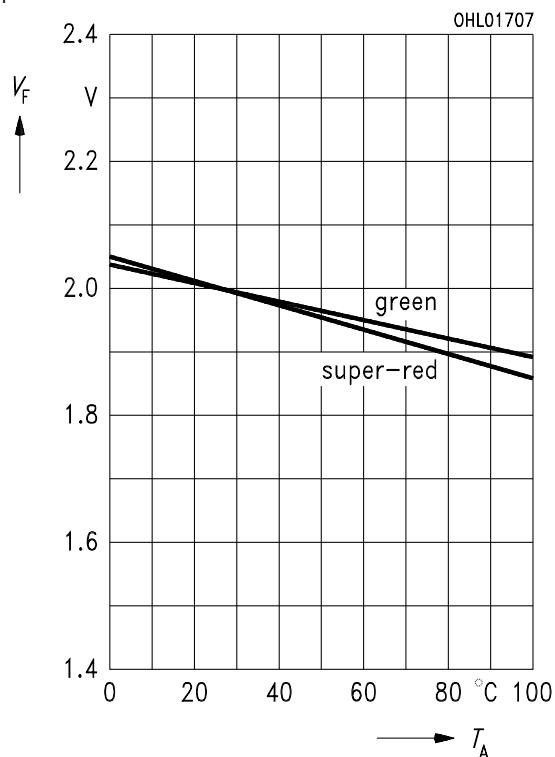
$I_F = 20 \text{ mA}$



Durchlaßspannung $V_F = f(T_A)$

Forward voltage

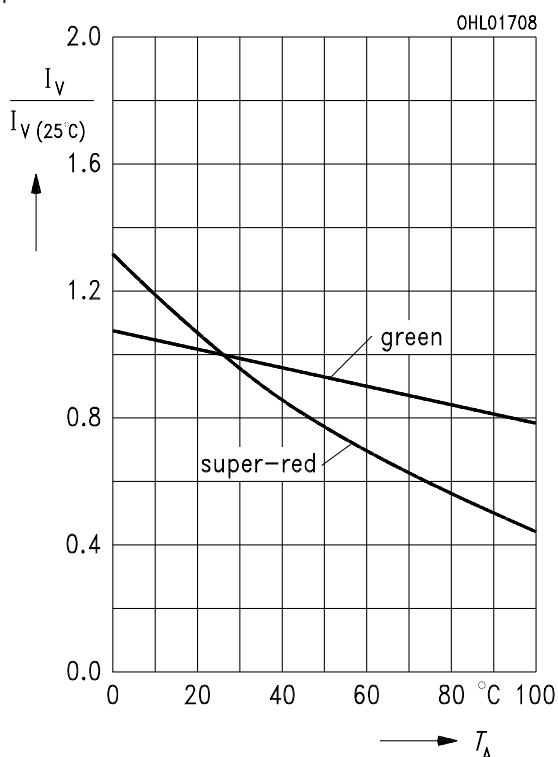
$I_F = 10 \text{ mA}$



Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_A)$

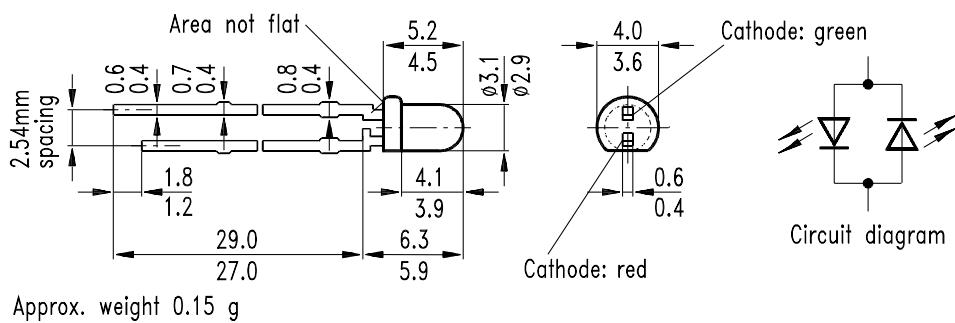
Relative luminous intensity

$I_F = 10 \text{ mA}$



Maßzeichnung Package Outlines

(Maße in mm, wenn nicht anders angegeben)
(Dimensions in mm, unless otherwise specified)



GELEX06729

Kathodenkennzeichnung:

grün: längerer Lötspeiß
rot: kürzerer Lötspeiß

Cathode mark:

green: long solder lead
red: short solder lead